

# 2SA883

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ / PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR

高周波増幅, 中速度スイッチング用 /

High Frequency Amplifier, Medium Speed Switching

通信工業用 / Industrial Use

2SA883 は、通信工業用モールドトランジスタシリーズ（新シリーズ）の一環として開発されたトランジスタで、特に高信頼度設計がなされており、計測器、端末機器等通信工業用分野に最適です。

特 徴 / FEATURES

- ・高周波増幅はもとより、スイッチング、低周波増幅など、広範囲な回路に使用できます。  
Suitable for switching and audio amplifier as well as high frequency amplifier.
- ・電源電圧の変動に対して余裕がある。V<sub>CEO</sub> : -40V  
Keeps stabilized operation against power voltage fluctuation.
- ・従来の拡散形トランジスタにくらべ、ベース逆バイアスを深くかけることができる。V<sub>EBO</sub> : -8.0V  
Available for deeper base reverse bias than with normal diffused transistors.
- ・直流電流増幅率が高い。h<sub>FE</sub> : 160TYP (I<sub>C</sub> = -10mA)  
High DC current gain.

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T<sub>a</sub> = 25°C)

項 目	略 号	定 格	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V <sub>CB0</sub>	-60	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V <sub>CEO</sub>	-40	V
エミッタ・ベース間電圧	V <sub>EBO</sub>	-8.0	V
コレクタ電流	I <sub>C</sub>	-200	mA
全損失	P <sub>T</sub>	300	mW
ジャンクション温度	T <sub>J</sub>	150	°C
保存温度	T <sub>stg</sub>	-65 ~ +150	°C

電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T<sub>a</sub> = 25°C)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I <sub>CB0</sub>	V <sub>CB</sub> = -40V, I <sub>E</sub> = 0			-100	nA
エミッタシャ断電流	I <sub>EBO</sub>	V <sub>EB</sub> = -5.0V, I <sub>C</sub> = 0			-100	nA
直流電流増幅率	h <sub>FE1</sub>	V <sub>CE</sub> = -1.0V, I <sub>C</sub> = -10mA	80	160	320	
直流電流増幅率	h <sub>FE2</sub>	V <sub>CE</sub> = -1.0V, I <sub>C</sub> = -100mA	40	80		
コレクタ飽和電圧	V <sub>CE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = -100mA, I <sub>B</sub> = -10mA		-0.2	-0.6	V
ベース飽和電圧	V <sub>BE(sat)</sub>	I <sub>C</sub> = -100mA, I <sub>B</sub> = -10mA		-0.9	-1.2	V
利得帯域幅積	f <sub>T</sub>	V <sub>CE</sub> = -10V, I <sub>E</sub> = 10mA	150	280		MHz
コレクタ容量	C <sub>ob</sub>	V <sub>CB</sub> = -10V, I <sub>E</sub> = 0, f = 1.0MHz		7.5	10	pF
ターンオン時間	t <sub>on</sub>			100		ns
蓄積時間	t <sub>stg</sub>	測定回路図参照/See test circuit		200		ns
ターンオフ時間	t <sub>off</sub>			270		ns

外形図 / PACKAGE DIMENSIONS  
(Unit:mm)

